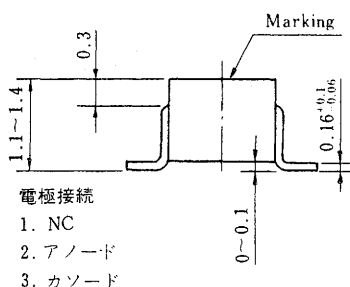
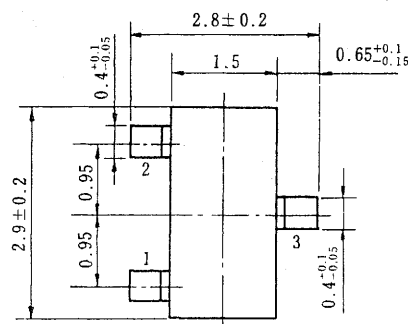


エピタキシャルプレーナ形シリコンダイオード
高速度スイッチング用

特 徴

- 超小形外形でありハイブリッドIC用として最適です。
(ミニモールドトランジスタと同一条件で組立可能)
- 容量が小さい。C=2.0 pF TYP.
- スイッチング速度が速い。t_{rr}=3.0 ns MAX.
- スイッチング用を始め、リミッタ、クリッパ等広範囲に使用できます。

外形図 (単位: mm)



絶対最大定格 (T_a=25 °C)

項 目	略 号	1SS220	1SS221	単 位
せん頭逆電圧	V _{RM}	70	100	V
直 流 逆 電 圧	V _R	70	100	V
サージ電流 (1 μs)	I _{F(surge)}	2000	2000	mA
せん頭順電流	I _{FM}	300	300	mA
平均整流電流	I _O	100	100	mA
熱 抵 抗	R _{th(j-a)}	0.67	0.67	°C/mW
接 合 部 温 度	T _j	150	150	°C
保 存 温 度	T _{stg}	-55~+150	-55~+150	°C

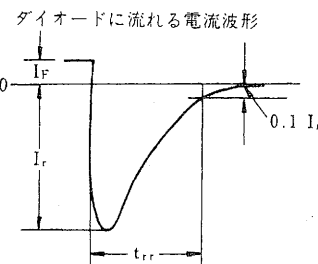
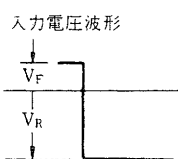
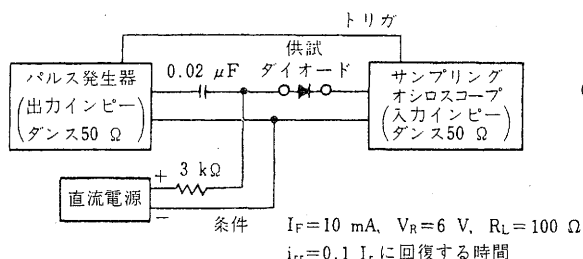
電气的特性 (T_a=25 °C)

項 目	略号	条 件	1SS220			1SS221			単 位
			MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	
順 電 圧	V _{F1}	I _F =10 mA	—	0.72	0.85	—	0.72	0.85	V
順 電 圧	V _{F2}	I _F =50 mA	—	0.85	1.0	—	0.85	1.0	V
順 電 圧	V _{F3}	I _F =100 mA	—	0.95	1.2	—	0.95	1.2	V
逆 電 流	I _R	V _R =70 V	—	—	0.1	—	—	—	μA
逆 電 流	I _R	V _R =100 V	—	—	—	—	—	0.1	μA
端 子 間 容 量	C _i	V _R =0, f=1.0 MHz	—	2.0	4.0	—	2.0	4.0	pF
逆 回 復 時 間	t _{rr}	注	—	—	3.0	—	—	3.0	ns

*基板実装後、コーティングや樹脂封止をすることにより高信頼度を保ちます。

品 名	捺 印
1SS220	A13
1SS221	A14

(注) t_{rr}測定回路



本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものとご確認の上ご使用ください。

特性曲線 (T_a = 25 °C)

